



适用于5G基础设施的 RapidRF Smart LDMOS前端设计

恩智浦的RapidRF Smart LDMOS前端设计进一步集成了高效射频功率放大器、线性预驱动器、带T/R开关的Rx LNA和环形器,整合在紧凑的封装中,同时功率放大器封装中包含偏置控制器和温度传感器。设计包含用于DPD反馈的耦合器,并将与数字预失真一起使用。

对于要求天线平均发射功率为2.5至8瓦(34-39 dBm)的5G射频单元, RapidRF参考板是上佳选择。通用PCB布局用于多个频段, 简化了设计和制造, 加快了产品面市速度。

主要特性

- 完整的RF TDD前端
 - PA
 - LNA
 - 收/发开关
- 带宽高达400 MHz
- 集成温度补偿自动偏置
- 更改频段仅需替换2个组件
- 双诵道Rx模块

目标应用

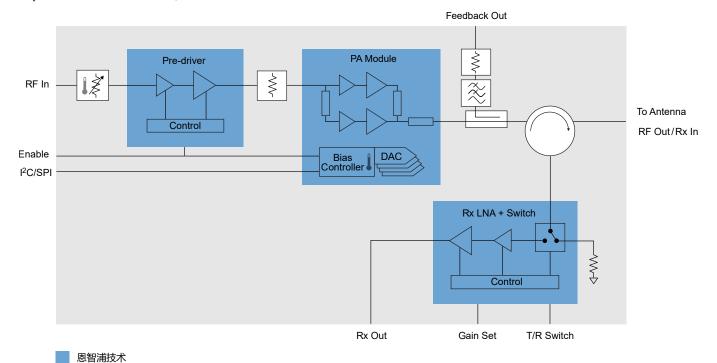
- 5G mMIMO有源天线系统(通常为64T64R)
- 大功率5G宏拉远头驱动器
- 室外小基站
- 开放RAN专有的无线接入网



优点

- 适用于多个频段和电源配置的通用封装
- 高度集成设备可减少BOM
- 简化制造:不再需要进行生产调谐或校准
- 兼具宽带性能的紧凑解决方案
- 简单的双电源设计

RapidRF Smart LDMOS结构框图



mMIMO有源天线系统示例

详细了解恩智浦的RapidRF Smart LDMOS前端设计:nxp.com.cn/RapidRFSL

相关产品

• <u>BTS6201U</u>: Tx前置驱动器

• A3M36SL039: 带自动偏置控制的功率放大器模块

• <u>BTS7203U</u>: 带LNA/Tx开关的Rx模拟前端IC

电路板设计文件包括:

• 电路板布局

原理图

• 电路板部件列表

• 机械图纸